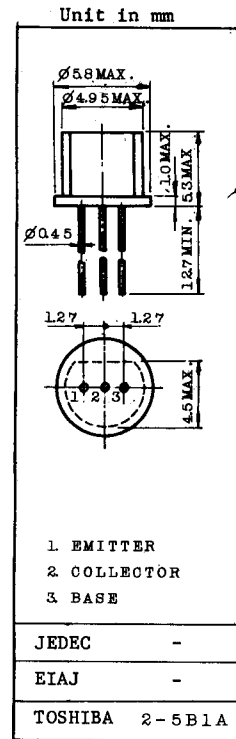


- 小電力増幅用
- Small Power Amplifier Applications
- 飽和電圧が低い； $V_{CE(sat)} = -0.25V$ (Max.)
- 2SC735とコンプリメンタリになります。
- Complementary to 2SC735

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	- 30	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	- 30	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	- 5	V
コレクタ電流	I_C	-400	mA
エミッタ電流	I_E	400	mA
コレクタ損失	P_C	300	mW
接合温度	T_j	125	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ 125	$^\circ C$



※ PCT 技術により製造されています。

Produced by Perfect Crystal Device Technology.

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25°C)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタしや断電流	ICBO	V _{CB} = -18V I _E = 0	-	-	-0.1	μA
エミッタしや断電流	IEBO	V _{EB} = -5V I _C = 0	-	-	-0.1	μA
直流電流増幅率 (Note)	hFE(1)	V _{CE} = -1V I _C = -100mA	70	-	400	
	hFE(2)	V _{CE} = -5V I _C = -400mA	23	-	-	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C = -100mA I _B = -10mA	-	-	-0.25	V
ベース・エミッタ間電圧	V _{BE}	I _C = -100mA V _{CE} = -1V	-	-	-1.0	V
コレクタ出力容量	C _{ob}	V _{CB} = -6V I _E = 0 f = 1MHz	-	13	-	pF

Note : hFE(1)および hFE(2) により下表のように分類し現品表示してあります。

According to the value of hFE(1) and hFE(2), the 2SA562 is classified as follows.

CLASSIFICATION	hFE (1)		hFE (2)
	MIN.	MAX.	MIN.
2SA562-0	70	140	23
2SA562-Y	120	240	40
2SA562-GR	200	400	67

2SA562

